

上海新阳半导体材料股份有限公司
关于对新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资及关联交易概述

（1）新阳硅密（上海）半导体技术有限公司（以下简称“新阳硅密”）为上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，本公司目前持有其45%的股权。现本公司与股东硅密四新半导体技术（上海）有限公司（以下简称“硅密四新”）以现金方式共同对新阳硅密进行增资，并于2017年6月12日签订《新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资协议》。此次增资完成后新阳硅密注册资本由 2000万元增至 5000万元，本公司对其持股比例保持不变。本公司增资金额为 1350 万元，全部为自有资金。

（2）公司于2017年6月12日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于对新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资的议案》。关联董事王福祥、孙江燕、吕海波回避表决，其他6名非关联董事参与表决。公司独立董事发表同意的事先认可及独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。本次对外投资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

（3）关联交易情况说明：公司高管王溯为新阳硅密的法人代表（董事长），同时系公司实际控制人、董事王福祥和孙江燕之子。故公司与新阳硅密发生的日常交易为关联交易。

（4）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、其他股东方介绍

合资股东：硅密四新半导体技术（上海）有限公司

成立日期：2011年6月9日

注册地址：上海市徐汇区龙华路2577号27幢123室

企业类型： 有限责任公司（国内合资）

法定代表人： 印琼玲

注册资本： 20 万元

主营业务： 太阳能，半导体、电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询（除经纪）、电子产品、机电设备、太阳能设备、环保设备及配件的销售，从事货物进出口与技术的进出口业务

股东构成：

股东种类	股东名称	出资金额	出资比例
有限责任股东	印琼玲	12 万元	60%
有限责任股东	印玉弟	8 万元	40%
	合计	20 万元	100%

上述当事人与上海新阳及其控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：新阳硅密（上海）半导体技术有限公司

公司性质： 有限责任公司（国内合资）

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：上海市松江区思贤路 3600 号 10 号楼 1 楼西侧

经营范围：生产电子行业的集成电路及半导体表面处理用的：电镀液、予处理与后处理溶液、清洗剂、助焊剂、抗氧化剂、化学添加剂、高纯试剂，并生产高速环型电镀生产线，高压水喷淋设备及配件，销售企业上述自产产品并提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

2、标的公司的股权结构

标的公司注册资本为 2000 万元人民币。其中：上海新阳出资 900 万元人民

币，持有 45%的股份；硅密四新出资 1100 万元人民币，拥有 55%的股权。本次增资各方均以现金增资，资金来源均为自有资金。

新阳硅密增资前后股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	本次认缴出资额	增资后出资金额（万元）	股权比例
1	上海新阳半导体材料股份有限公司	900	1350	2250	45%
2	硅密四新半导体技术（上海）有限公司	1,100	1650	2750	55%
注册资本总额		2,000	3000	5000	100%

3、本次投资的相关情况

本次增资后标的公司注册资本为 5000 万元人民币，主营业务如下：

- 1) 300MM 电镀设备的研发和生产
- 2) 300MM 批量式湿法设备的研发和生产
- 3) 设备翻新业务与平台建设

截至 2016 年 12 月 31 日，新阳硅密经审计资产总额 46,396,693.26 元，负债总额 24,120,036.58 元，净资产 22,276,656.68 元，2016 年度营业收入 30,080,224.94 元，净利润 2,451,139.70 元。截至 2017 年 3 月 31 日，新阳硅密资产总额 47,425,763.46 元，负债总额 26,336,828.31 万元，净资产 21,088,935.15 元，2017 年 1-3 月营业收入 4,115,280.00 元，净利润 -1,187,721.52 元（以上一季度数据未经审计）。

本次增资完成后将加速新阳硅密在半导体晶圆级封装领域的业务发展，提高新阳硅密综合竞争力和持续发展能力。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合同当事人

甲方：上海新阳半导体材料股份有限公司

乙方：硅密四新半导体技术（上海）有限公司

（二）合同主要条款

1、新阳硅密注册资本由 2000 万元增至 5000 万元，本公司对其持股比例保持不变。见本公告第三条新阳硅密增资前后股权结构

2、标的公司注册资本增为 5000 万元人民币。其中：上海新阳出资 1350 万元人民币，硅密四新出资 1650 万元人民币。本次增资各方均以现金增资，资金来源均为自有资金。增资后双方持股比例不变。

3、 合同生效条件和生效时间

本合同于 2017 年 6 月 12 日由双方共同签署，获得双方权力机构批准后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

发展半导体晶圆级封装湿制程设备制造和翻新业务，同时融合半导体湿法设备与化学药液材料两大方面的创新先进技术，打造完整的一体化技术服务平台，为前段、中段、后段半导体生产客户提供完整的一站式工艺、设备及技术服务，使公司逐步发展为半导体行业国际化龙头公司。

2、存在的风险

（1）市场竞争风险

全球装备产业整合加速，装备产业形成强者恒强的格局，市场垄断和技术壁垒是国产设备的无法回避的问题。外国知名半导体设备企业在华加大投资力度，争抢高端技术人才，降低运营成本和抢占中国市场。与外国半导体设备制造企业相比，中国国产半导体设备制造水平低，市场影响力相对小，面临市场竞争的风险。

本项目立足于国内市场，充分发挥各投资方已有的客户资源优势和市场影响力，借助国家产业政策的大力支持，以及本土化供应的成本优势和效率优势，积极进行市场开拓，与客户形成良好的互动关系，最大程度的降低市场竞争风险。

（2）技术风险

本次增资的目标是开发两大类设备：300mm 批量式清洗机与 300mm 单片电镀机。每一类设备的研制都是一个巨大的挑战，面临一定的技术风险。

公司把平台定位在中后段上避免了部分技术难关，充分发挥我们已有的经验，借助投资方原有的技术积累和先进的技术平台，组建一支具有较强工艺及设备研制能力的技术团队，建立目前亚洲唯一的晶圆电镀工艺实验室，能够完成研发、

小试、中试并模拟客户现场进行工艺实验，同时积极寻找更多的合作伙伴，不断完善核心技术提升竞争优势。

（3）投资项目无法实现预期收益的风险

半导体行业设备更换周期相对长，应用认证时间长。虽然公司在决策过程中综合考虑了各方面的情况，为投资项目作了多方面的准备，但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、国家产业政策变化以及客户开发、产品市场销售状况等变化因素的影响。如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力，公司将会面临投资项目无法达到预期收益的风险。

公司将组建专业项目团队，确保资金及时到位，制定周密的项目实施方案，积极争取国家产业扶持政策，尽力确保项目顺利实施并达到预期收益。

3、对公司的影响

本次增资的实施有助于增强上海新阳在半导体晶圆级封装领域的市场竞争力，形成在晶圆级封装领域材料和设备的配套优势，进一步提升上海新阳在半导体行业的影响力，具有良好的经济效益和社会效益。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司对新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资是公司业务发展的必要，不存在损害公司及中小股东的利益。同意将上述关联交易相关议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

公司对新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资能够加速公司在半导体晶圆级封装领域的业务发展，提高公司综合竞争力和持续发展能力，促进公司综合效益的提升。本次关联交易事项已获公司第三届第十五次董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了关联交易决策程序。审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们一致同意本次关联交易事项。

七、中介机构意见结论

保荐机构审阅了上海新阳本次关联交易的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以及公司关于同类产品和服务销售定价说明。经核查，保荐机构认为：上海新阳本次对参股子公司增资符合公司经营活动的需要，上述补充确认的关联交易及对参股子公司增资已经第三届董事会第十五次会议以及第三届第十次监事会会议审议通过，并已经独立董事认可、发表了独立意见，符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》等文件的规定。保荐机构对上海新阳本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关关联交易的事先认可意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
5. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司对新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资暨关联交易的核查意见；
6. 增资协议。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2017年6月13日